D1FH3

30V 3A

特 長

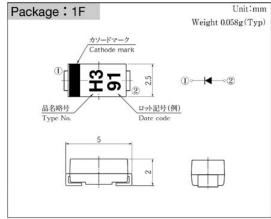
Feature

- 小型SMD
- Small SMD
- 極超低 V_F=0.36 V
- Super-Low V_F=0.36V

MainUse

- バッテリー逆接防止 Reverse connect protection for DC power source
- DC/DCコンバータ
- DC/DC Converter
- 携帯電話、パソコン
- Mobile phone, PC

■外観図 OUTLINE



外形図については新電元Webサイト又は〈半導体製品一覧表〉をご参照 下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site or Semiconductor Short Form Catalog. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

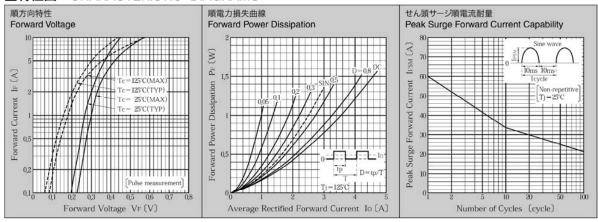
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25℃)

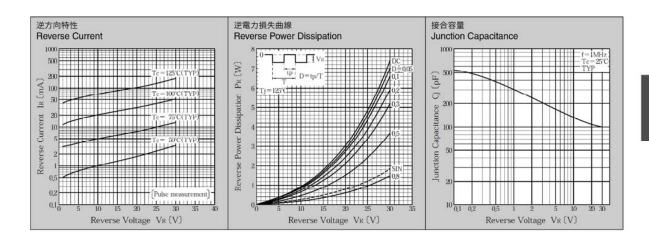
項 目 Item	記号 Symbol	条件 品名 Type No.	D1FH3	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~125	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		125	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	$V_{\rm RM}$		30	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	Io	50Hz正弦波, 抵抗負荷, Tc=95℃ 50Hz sine wave, Resistance load, Tc=95℃	3.0	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波、非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj=25℃	60	A

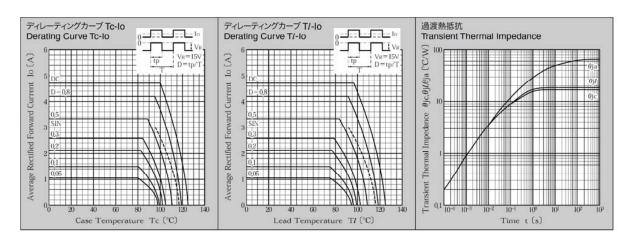
●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25℃)

順電圧 Forward Voltage	17	I _F = 1.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.30	V
	VF	I _F = 3.0A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.36	, v
逆電流 Reverse Current	I_R	V _R = V _{RM} 。 パルス測定 Pulse measurement	MAX 2.0	mA
接合容量 Junction Capacitance	Cj	$f = 1MHz$, $V_R = 10V$	TYP 130	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ jc	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 16	°C/W
	θ j l	接合部・リード間 Junction to lead	MAX 18	
	θ ja	接合部・周囲間、プリント基板実装 Junction to ambient, On glass-epoxy substrate	MAX 65	

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS







^{*} Sine wave は50Hzで測定しています。
* 50Hz sine wave is used for measurements.
* 半導体製品の特性は一般的にバラッキを持っております。
Typical は統計的な実力を表しています。
* Semiconductor products generally have characteristic variation.
Typical is a statistical average of the device's ability.